３　ビーム冷陰極電界放出型の電子ビーム源
４　二以上の電子ビーム源

シ　計測装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　露光前にウエハー形状パラメータを測定し、開口数一・三超の液浸レンズを有する深紫外リソグラフィ装置又は極端紫外リソグラフィ装置の重ね合わせ誤差又はフォーカスを改善するために測定値を利用するように設計したスタンドアロン装置
（二）　画像ベースの重ね合わせ誤差又は回折ベースの測定技術を用いて、製品ウエハー上のレジスト現像後又はエッチング後のフォーカス又は重ね合わせ誤差を測定するように設計した測定装置で、〇・五ナノメートル以下の重ね合わせ誤差測定精度を有するものであって次のいずれかを有するもの
１　トラックへの組み込み用に設計されたもの
２　高速波長切り替え機能を有するもの

十七の二　半導体素子、集積回路又は半導体物質の製造用の装置又は試験装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ　半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡であって、次の（一）から（七）までの全てに該当するもの（国際半導体製造装置材料協会が定めたＳＥＭＩ規格に準拠したウエハーの搬送・保管容器（二〇〇ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド（ＦＯＵＰ）を含む。）用にウエハー搬入部を設計したものを除く。）
（一）　ステージの位置決め精度が三〇ナノメートル未満のもの
（二）　レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能なもの
（三）　レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能なもの
（四）　画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇を超える画像の収集及び保存が可能なもの
（五）　画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で五パーセント未満のもの
（六）　画像を結合する際の視野の重なりが五〇ナノメートル未満のもの
（七）　加速電圧が二一キロボルトを超えるもの

ロ　極低温ウエハープローバ装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの
（一）　零下二六八・六五度以下の温度で試験を行うことができるように設計したもの
（二）　直径が一〇〇ミリメートル以上のウエハーに対応するように設計したもの

十七の三　集積回路の製造用のマスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの

イ　マスク又はレチクル（ニに該当するものを除く。）であって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの又はこれらの部分品若しくは附属品（ホに掲げるものを除く。）

ロ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの（イに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）又はその部分品若しくは附属品

（新設）

十七の二　ペリクルであって、極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの

（新設）